





(19) Japan Patent Office

(11) Unexamined Patent Application Publication No. Sho 49-122292

(43) Published on November 22, 1974

(21) Patent Application No. Sho 48-33213

(22) Filing Date: March 22, 1973

Request for examination: not yet

(52) Japanese Classification: 99(5) J 4, 99(5) C22

JPO reference No. 7377 57, 6851 57

Request for patent (1)

March 22, 1973

To: Commissioner of Patent Office

Title of the invention: MANUFACTURING METHOD OF LIGHT-EMITTING DIODE

WITH IR-VISIBLE LIGHT CONVERSION FUNCTION

Inventor: Tonao YUASA

c/o Nippon Denki Kabushiki Kaisha, 7-15, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo Applicant: (423) Nippon Denki Kabushiki Kaisha, 7-15, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo

Koji KOBAYASHI, President

Representative: (6591) Shin UCHIHARA, Patent Attorney

c/o Nippon Denki Kabushiki Kaisha, 7-15, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Tel (452)1111

Specification

Title of the Invention: MANUFACTURING METHOD OF LIGHT-EMITTING DIODE WITH IR-VISIBLE LIGHT CONVERSION FUNCTION Claim(s)

A manufacturing method of a light-emitting diode with an IR-visible light conversion function, comprising: forming a recess in the shape of truncated cone or similar shape at the center of a diode stem; mounting a pellet including a p-n junction and emitting infrared light, on the bottom of the recess; dropping a given amount of an IR-visible light conversion phosphor material into the recess to form an IR-visible light conversion phosphor layer with a given thickness around said pellet; dropping an adhesive onto the layer; heating them to solidify and fix the IR-visible light conversion phosphor material around said pellet; and performing lens-sealing or molding.









Partial English translation (from p.2, column 3, l.18 to p.2, column 6, l.19)

According to the present invention, a diode stem 11 as shown in Fig. 2 is employed. At the center of the diode stem, a recess 3 in the shape of truncated cone or similar shape is formed. A pellet 6 including a p-n junction and emitting infrared light is mounted on the bottom of the recess 3 which has the truncated cone or similar shape, as shown in Fig. 2. Next, as shown in Fig. 3, an adequate amount of an IR-visible light conversion phosphor material is dropped into the recess 3 from above the stem 11 to form a phosphor layer 7 around the pellet 6. If the dropped amount of the phosphor material is constant, the thickness of the phosphor layer 7 is always constant.

Next, in order to improve the adhesion between the phosphor layer 7 and the pellet 6, as shown in Fig. 4, an adequate amount of a thermoplastic resin 5 is dropped. In this case, the thermoplastic resin 5 has a suitable viscosity and is, for example, a silicon resin or an epoxy resin. Then, the thermoplastic resin 5 and the phosphor layer 7 configured as shown in Fig. 4 are gradually heated to penetrate the thermoplastic resin 5 into the phosphor layer 7. After hardening with heating, lens-sealing or molding with an epoxy resin is performed.

In the above-described manufacturing process, the injection of the IR-visible light conversion phosphor material 7 is performed using an injector apparatus 4 such as an injector as shown in Fig. 3. Also, the dropping of the silicon resin or epoxy resin is performed using a dropping apparatus 8 such as an injector as shown in Fig. 4.. In these processes, the stem 11 is sequentially moved to the positions immediately below the injector apparatus 4 and the dropping apparatus 8. First, when the recess 3 having the truncated cone or similar shape of the stem 11 is positioned immediately below the injector apparatus 4, the injector apparatus 4 drops the phosphor material into the recess 3 to form the phosphor layer 7. Then, the stem 11 is moved to be positioned immediately below the dropping apparatus 8. The dropping apparatus 8 then drops the silicon resin or epoxy resin into the recess 3. This can achieve a fully-automated operation of phosphor coating. Consequently, operations are simplified to decrease the required process steps. In addition to this, the thickness of the phosphor layer 7 is always controlled to be constant. This can achieve high reproducibility for the visible light output. The thus manufactured light-emitting diode having an IR-visible light conversion function can reflect the emitted IR light with the use of the recess 3 in the shape of truncated cone or similar shape. Accordingly, the amount of IR light absorbed by the phosphor material increases, thereby increasing the output of visible light.











Brief Description of the Drawings

Fig. 1 is a schematic view showing the structure of a diode stem and an infrared light-emitting diode mounted thereon, for illustrating a conventional manufacturing method. In the drawing, reference numeral 1 denotes the diode stem, and 2 a pellet emitting infrared light and having a p-n junction.

Figs. 2, 3, and 4 are diagrams for illustrating the present invention. Fig. 2 is a schematic view showing the structure of a diode stem and an infrared light-emitting diode mounted, in which reference numeral 3 denotes a recess in the shape of truncated cone, 6 a pallet having a p-n junction and emitting infrared light, and 11 a diode stem. Fig. 3 is an explanatory view showing the process of forming an IR-visible light conversion phosphor layer, in which reference numeral 3 denotes the recess in the shape of truncated cone, 4 an apparatus for injecting a phosphor material, 6 the pellet having a p-n junction and emitting infrared light, 7 a phosphor layer, and 11 the diode stem. Fig. 4 is a view for explaining the drop of an adhesive, in which reference numeral 3 denotes the recess in the shape of truncated cone, 5 a thermoplastic resin, 6 the pellet having a p-n junction and emitting infrared light, 7 the phosphor layer, 8 a dropping apparatus for dropping the thermoplastic resin, and 11 the diode stem.









願(/) 特 許



一月 年. 昭和

40 3.22

(2,000円) 特許庁長官 殿

発明の名称

etがイカ シヘンカンハクコウ 食外可養安装養先メイオ

発

重点和港区艺五丁目7番15号 日本電気株式会社内



代

東京都港区芝五丁目7都15号 (423)日本電気株式会社 代表者 社 及 小 林 宏 治

芝五丁117 香15分 〒 108 東京都 日本電気株式会社内

(6591) 弁理士 内 7825 (452)1111(大代表)

48 033213.

お外可視安神器光ダイオードの観 発明の名称 造方法

特許 請求の範囲

ダイオードステムの中央部に円錐台形もしくは 円錐台形に強似した形状の凹みを設け、凹みの &に P-n 接合を含み赤外級を発光するペレット を扱着し、一定量の赤外可視変換金光体を凹み **に楽し、顔記ペレットの周囲に一定の身さの水** 外可視変換餐光体の脂を形成せしめ、さらにそ の上に接着剤を終下し、加熱し:赤外可視変換 優先体を前記ペレットの周囲に位者せしめ、さ られレンス對止あるいはモール! 1ることを特 ほとする赤り可視変換発光ダイボードの製造方 法。

卒明の詳細な武当

本船明过那外司确定片首升体,广席体材料から 戦る 3−x 総合を含み赤外級をお付けるペレット

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 49 - 122292

43公開日 昭49.(1974)11.22

21特顯昭 48 - 332/3

②出顯日 昭45.(1973)分.22

審査請求 未請求

(全3頁)

庁内整理番号

52日本分類

7377 57 6851 57 996)14 9910C22

から補成された赤外可依変換発光ダイオードの製 進方法に與するものである。

シリコンをドナータよびアクセプター不純物と して用いた単化ガリクムから成る アーs 装合を有し 赤外線を放射するペレットと何えば増感剤として イッテルビウム,活性剤としてエルビウムを用い **た弗化イットリクム製光体を組み合わせた赤外**母 視変換発光ダイオードはよく知られている。かか る蛯光ダイオードの製造にかいては,従来曼光体 をシリコン国際でたはエポキン側廊にませ合わせ て、前1凶のどとくダイオードステム1トに火撃 された、 P-n 狭合を含みみ外継を放射するペック トまの周囲に適当な市具を用いて映鉄線下で取る ととにより行なわれているが、との方法ではペレ ァトの大きさが通常 0.5 × 0.5 mm の小さな面がであ り。その上に1==程度の厚さに変化体を盛布しな ければならないので、作業が非常に内臓であり、 時間がかかり工数が多く、しかも水布された盤光 体の厚さは再境性に乏しかつた。といため可視尤 の山力のはらつをが不をくなり,しからペレット

(:)

(1)

15







11

より出た赤外光が十分に利用されないため可視光 の興度が低くなるといり欠点があつた。

本発明の目的は上述のごとを欠点を有する赤外 可視変換発光ダイオードの製造方法を改良し、か つ自動化可能な製造方法を提供することにある。

本発明によればダイオードステムの中央部に円 総合形もしくは円錐台形に製似した形状の凹みを 設け、凹みの底に P-n 接合を含み赤外線を発光す るペレットを装着し、一定量の赤外可視変換後光 体を凹みに落し、前配ペレットの周囲に一定の厚 さの赤外可視変換後光体の層を形成せしめ、さら にその上に接着剤を減下し、加熱して赤外可視変 換後光体を前配ペレットの周囲に固着せしめ、さら らにレンズ封止あるいはモールドすることを特徴 とする赤外可視変換発光ダイオードの製造方法が 18 出われる。

以下本発明について図面により詳述する。 本発明によれば第2回に示すようにダイオードステムの中央部に円錐台形もしくは円錐台形に類似した形状の凹み3を持つたダイオードステム11

(1)

世。かよび留下装置。の其下に原次移動せしめ、 まず第3回に示すよりにステム11の円錐台形も しくは円錐台形に類似した形状の四分3が注入装 置▲の真下にきたとき住入英援▲により張光体を **削み 3 に第下せしめ発光体層 7 を形成し、次にス** ナム11を移動し凹みまが満下装置 8 の実下にき たとも凹みるにシリコン街駅ないしはエポキシ樹 服を施下せしめれば螢光体量布は完全に自動的に 行なりことができる。従つて作業は簡単になり、 工数は減る。しかも螢光体層1の厚さを常に一定 10 に制御できるため、可視発光出力の再現性を高く **することが可能である。加りるにかかる手段によ** つて作られた歌外可視空後発光ダイオードは赤外 光が周囲の円錐合形もしくは円錐合形に無似した 形状の凹み 1 によつて反射されるために 優光体に 18 吸収される赤外光が増加する。従つて可視光の出 カが増大するという特殊をも有する。

図面の簡単な説明

第1因は従来の製造方法を説明するための凶で

學問 昭49一 1 2 2 2 9 2 2)

を用いる。 P-R 接合を含み赤外線を放射するペレット 6 は第 8 図に示した円盤合形または円錐合形に類似した凹み 3 の底に装着される。次に斜 3 図に示すよりにステム 1 1 の上方より過過量の赤外可視変換量光体を凹み 3 に落し、ペレット 6 の周囲に優光体展 7 を形成する。この際量光体の量が一定であれば優先体層 7 の厚さはほに一定となる。

次に签先体層すとペレット6との密港度をよく するために、第4図のごとく、例えばシリコン樹 崩、またはエポキシ樹脂のような適当な粘度の熱 硬化性樹脂5を適当量満下する。第4図に示した 熱硬化性樹脂5を急光体層すを徐熱し、熱硬化性 樹脂5を優先体層すの中に浸透させ、さらに加熱 硬化させた後レンズ對止あるいはエポキシ樹脂に よるモールドを行なり。

上述の製造過程において赤外可視変換・接光体 すの注入を第1因に示すような注射器のごとを注 入装置4,シリコン樹脂ないしはエポキシ樹脂の 調下を第4回に示したような注射器のごとを摘下 装置8を用いて行ない、ステム11を前記注入装

(4)

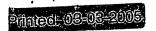
ダイオードステムシよび装着されたお外苑光ダイ オードの概略構成図である。図にかいて1はダイ オードステム。3は赤外線を放射し 2−x接合を有 するペレットを示す。

第3因,第3因,第4個は本発明を設明するための因で,第3因以ダイオードステムと接着された赤外発光ダイオードを示す報略構成因であり,3は円錐台形状の四分,4はデーa接合を有し赤外線を放射するペレット,11はダイオードステムを表力す。第3因は赤外可収支換を光体層の四四分。4は長光体を注入するための装置,4はダイオードステムを表力す。第4回は接着を記し赤外線を放射するペレット,7は接光体層、11はダイオードステムを表力す。第4回は接着、11はダイオードステムを表力す。第4回は形の四分,3は新硬化性制度,6は下支援の方面が表現のであり、3は一次の方面であり、1は対した大体層、6は高硬化性制度の有下に用いる減下支援、11はダイオードステムを示す。

八字: 2季1: 門原

(•)

-454-





系付容類の目母

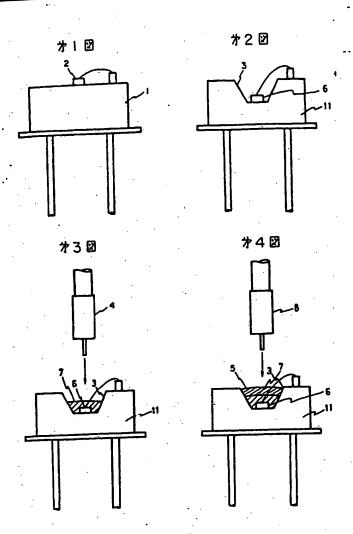
任



特別 昭49—122292 (3)

1通

1通 1通 1通



BEST	AVAIL	ABLE	COPY
------	--------------	------	-------------